

〈 SiC² 2023 컨퍼런스 일정 〉

6월 21일 (수)

시간	프로그램	좌장	장소
10:00 ~ 18:00	등록		로비(1F)
11:30 ~ 13:00	중식		썬큰가든(B1)
13:20 ~ 13:40	인사 및 프로그램 소개	방욱(한국전기연구원)	메도우홀(2F)
13:40 ~ 14:10	[Invited] 차세대 화합물 전력반도체 고도화 기술개발 ▶ 발표자 : 구용서(단국대학교)	김형우(한국전기연구원) 서한석((재)포항산업과학연구원)	메도우홀(2F)
14:10 ~ 16:10	Industrial Session : Part 1		
16:10 ~ 17:00	[특별강연 I] Harvesting Solar Energy Beyond SQ Limit ▶ 발표자 : 이영희(성균관대학교)		
17:00 ~ 17:50	[특별강연 II] 디스플레이 산업의 새로운 기회와 디스플레이 재료의 방향성 ▶ 발표자 : 곽태형(LG디스플레이)	기현철(한국광기술원)	오디토리움(1F)
17:50 ~ 18:10	[특별강연 III] 전기전자재료 산업의 기회와 새로운 도전 ▶ 발표자 : 박대희(원광대학교)		
18:30 ~ 20:00	〈2023 하계학술대회〉 환영리셉션	기현철(한국광기술원)	그랜드볼룸(2F)

〈다음 장에 계속〉

6월 22일 (목)

시간	프로그램	좌장	장소
08:30 ~ 17:00	등록		로비(1F)
09:50 ~ 10:50	[Tutorial] Revisiting the Stacking Faults in 4H-SiC Epilayers and Their Characterizations by Wafer-Level PL Mapping and HAADF STEM ▶발표자 : 홍순구(충남대학교)	방욱(한국전기연구원)	메도우홀(2F)
10:50 ~ 11:10	[Oral] SiC 전력반도체 소자의 우주방사선 영향 평가 ▶발표자 : 윤영준(한국원자력연구원)		
11:10 ~ 11:30	[Oral] Gate Ringing and Dynamic Capacitance of SiC MOSFETs ▶발표자 : 이연주(한국에너지공과대학교)		
11:30 ~ 13:00	중식		썬큰가든(B1)
13:00 ~ 13:40	[Invited] SiC의 응용분야: 파워모듈 패키지와 xEV에의 응용 관점에서 ▶발표자 : 윤상원(한양대학교)	구상모(광운대학교)	메도우홀(2F)
13:40 ~ 14:00	[Oral] 멀티에피를 활용한 1,700 V P-shielding Trench Gate MOSFET 성능 개선 ▶발표자 : 경신수(파워큐브세미)		
14:00 ~ 14:20	ICSCRM TPC 보고		
14:20 ~ 14:40	Break Time		
14:40 ~ 15:20	[Invited] A Study on 150 mm 4H-SiC Bulk Single Crystal Growth Using Recycled Powder ▶발표자 : 여임규((재)포항산업과학연구원)	이원재(동의대학교)	메도우홀(2F)
15:20 ~ 15:40	[Oral] 접촉각을 활용한 SiC단결정의 표면특성 정량분석 연구: 결정다형, 극성면, 자연산화막 및 표면 가공상태 의존성 ▶발표자 : 김정곤(Wafer Masters Inc.)		
15:40 ~ 16:00	[Oral] 전력반도체 및 양자응용을 위한 다이아몬드 단결정 반도체 기술 ▶발표자 : 남옥현(한국공학대학교)		
16:00 ~ 16:30	Break Time (※ 기기전시 부스 방문)		
16:30 ~ 17:20	포스터 발표(PE-01~PE-28)	배현철(한국전자통신연구원)	로비(2F)
18:20 ~ 18:30	우수 발표 시상식	방욱(한국전기연구원)	메도우홀(2F)
18:30 ~ 20:30	SiC인의 밤	문정현(한국전기연구원)	메도우홀(2F)